

GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 16 Amperes

FEATURES

- * Low power loss, high efficiency
- * Low forward voltage drop
- * Low thermal resistance
- * High current capability
- * High surge capability
- * High reliability

MECHANICAL DATA

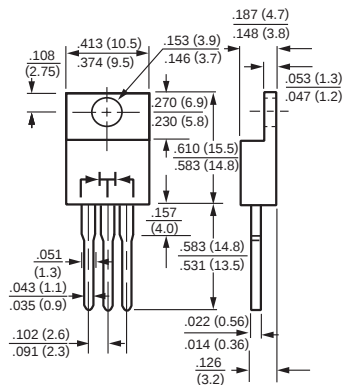
- * Case: TO-220 molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 2.24 grams
- * Polarity: As marked

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



TO-220



MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	RL16 01C	RL16 02C	RL16 03C	RL16 04C	RL16 05C	RL16 06C	RL16 07C	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current Tc = 100°C (Note 1)	Io	16.0							Amps
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	200							Amps
Typical Thermal Resistance	RθJC	3.0							°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 2)	CJ	40							pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-65 to + 150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	RL16 01C	RL16 02C	RL16 03C	RL16 04C	RL16 05C	RL16 06C	RL16 07C	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 8.0A DC		V _F	1.1							Volts
Maximum DC Reverse Current	@T _C = 25°C	I _R	10							uAmps
at Rated DC Blocking Voltage	@T _C = 100°C		100							

- NOTES : 1. Case Temperature Measured at Metal Tab.
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.
3. Suffix " A " = Common Anode.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (RL1601C THRU RL1607C)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

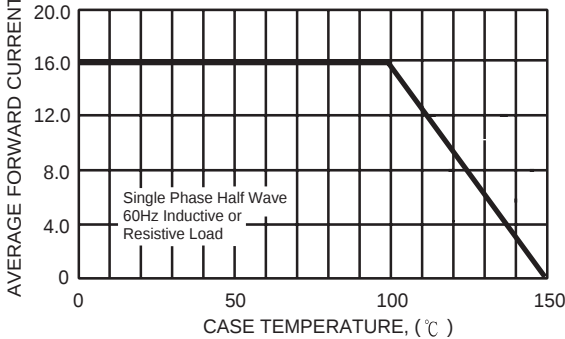


FIG. 2 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

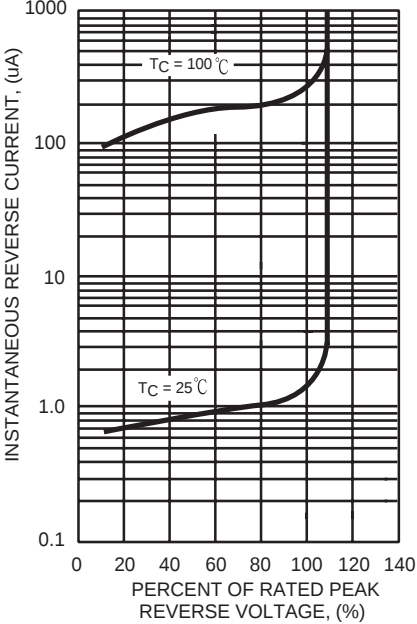


FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

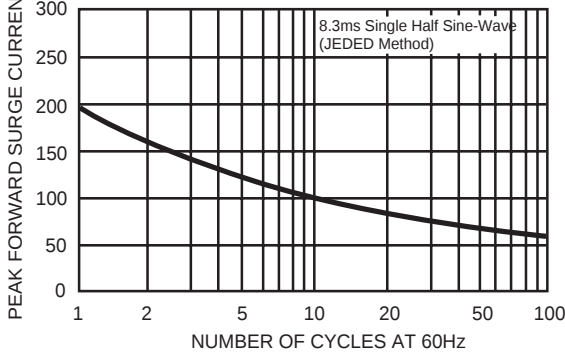


FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

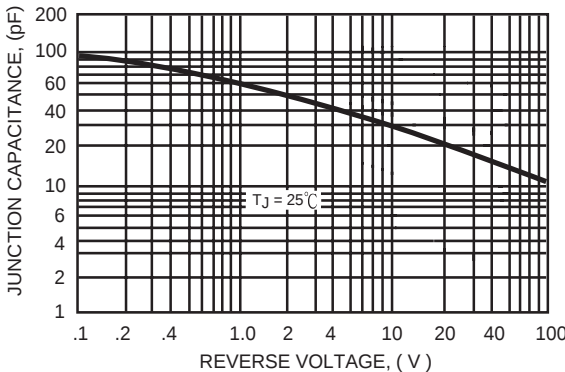
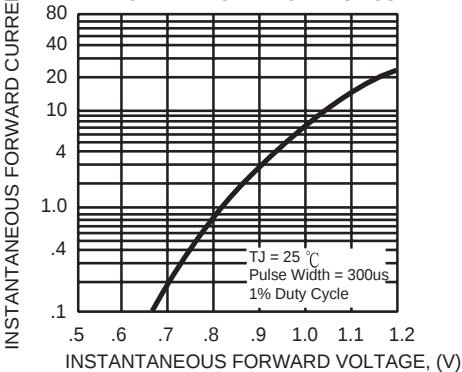


FIG. 5 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9